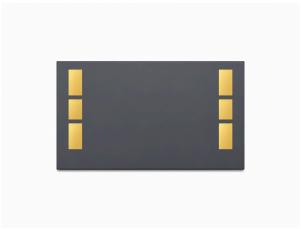
12000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX es un die limitador GaAs PIN para 12000–18000 MHz, diseñado para limitar la potencia RF antes de componentes sensibles a la potencia.



Pérdida de inserción: 0.6 dB (típico) / 0.7 dB (máximo); Nivel de limitación: 16.5 dBm (típico) / 17.5 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 43 dBm (máximo) (τ = 1 ms; D = 20%). Dimensiones del die: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	-	12000	-	18000	-	MHz
Pérdida de inserción	-	-	0.6	0.7	-	dB
VSWR de entrada	-	-	1.4	-	-	-
VSWR de salida	-	-	1.4	-	-	-
Nivel de limitación	-	-	16.5	17.5	-	dBm
Potencia máxima de entrada pulsada	-	-	-	43	τ = 1 ms; D = 20%	dBm

Condiciones ambientales

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de funcionamiento	-	-55	-	125	°C

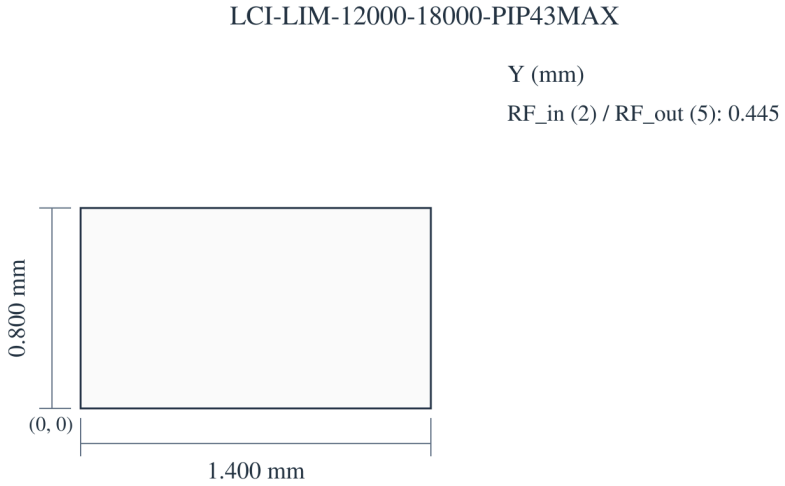
Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	Función	Notas
2	RFin	Entrada RF	50 Ω
5	RFout	Salida RF	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Pad de masa para prueba con sonda	-

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	1.4 × 0.8 × 0.1	mm

Referencia dimensional parcial en mm. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.



Registro de la publicación actual · 1.7 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.6.

Integración del chip y secuencia de polarización

La entrada y la salida integran condensadores de bloqueo DC.

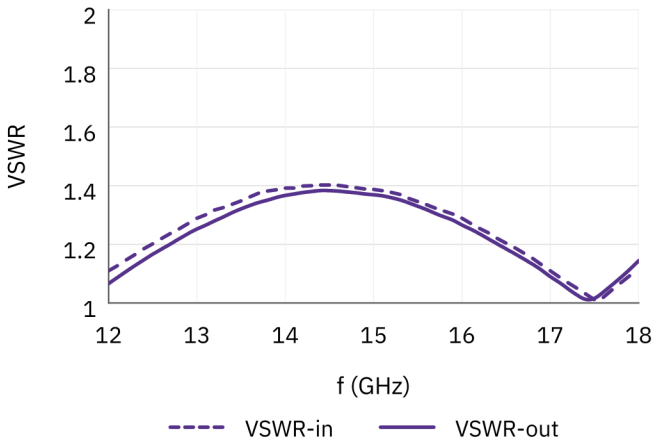
Curvas de rendimiento

Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

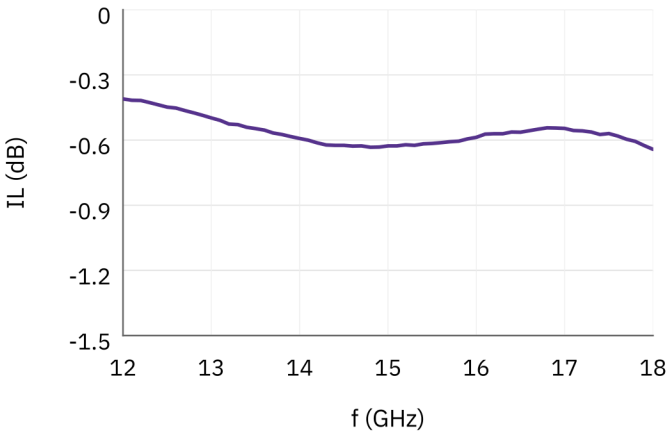
Adaptación de entrada y salida; Pérdida de inserción.

Notas de la figura: TA=+25°C. Las lecturas son aproximadas.

VSWR



IL



Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.